## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年5月26日現在

機関番号:17201 研究種目:若手研究(B) 研究期間:2009~2010 課題番号:21740401 研究課題名(和文) プラズマスパッタリングとプラズマ流を利用した微粒子含有酸化亜鉛薄
腺熱電素子の開発 研究課題名(英文) Development of ZnO thermoelectric thin film with fine particle using plasma sputtering and plasma flow 研究代表者
三沢 達也(MISAWA TATSUYA) 佐賀大学大学院工学系研究科・助教 研究者番号: 70346873

研究成果の概要(和文):

高性能の熱電薄膜材料の実現の為に,放電プラズマ焼結プロセスにおける内部構造制御のメカニズムの解明と,プラズマスパッタリングとプラズマ流を併用した微粒子含有酸化 亜鉛薄膜のプラズマ成膜装置の開発を行った.

## 研究成果の概要(英文):

For the realization of the high-performance thermoelectric thin film materials, the study of mechanism of the internal construction control in sintered specimen on Spark Plasma Sintering process and development of ZnO thermoelectric thin film with fine particle using plasma sputtering and plasma flow were carried out.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	1, 200, 000	360, 000	1, 560, 000
2010 年度	1, 000, 000	300, 000	1, 300, 000
年度			
年度			
年度			
総計	2, 200, 000	660, 000	2, 860, 000

研究分野:数物系科学

科研費の分科・細目:プラズマ科学・プラズマ科学

キーワード: 放電プラズマ焼結プロセス, プラズマスパッタリング, 熱電変換材料, 酸化亜鉛 セラミックス, 金属酸化物薄膜

## 1. 研究開始当初の背景

本研究では、省エネルギー技術の一環とし て廃熱の有効利用という観点から、廃熱を高 効率で熱電変換する酸化亜鉛系熱電材料と 廃熱利用技術の開発を目的としている. 現代社会では、人間の日常生活を支えるほぼ すべての機器やプラントから、多量の廃熱を 放出しており、非常に大きなエネルギー損失 となっている.現在、大型プラントにおいて は廃熱の再利用技術が運用されているが、巨 大な設備を必要とし、利用可能範囲がプラン トの周辺設備などに限られるなど、有効に使 用されているとは言い難い.一方、廃熱熱源 のかなりの部分を占める小規模の機器に関 しては、廃熱利用はほとんど省みられておら ず、潜在的かつ多量のエネルギー損失が生じ ていると言える.

地球温暖化防止や二酸化炭素削減などの 観点から、さらなる省エネルギー技術として ①様々な規模のプラントや機器で利用でき る効率的な廃熱再利用技術の確立は、将来的 に必要である.また近年、原油や資源の枯渇 と価格上昇に伴って、エネルギー及び資源の 獲得競争が国際的に激しくなることが、非常 に懸念されている.これらの点から、②比較 的豊富な資源を利用した廃熱の高効率利用 による省エネルギー技術の開発が必要であり、廃熱の高効率再利用技術を確立する上で、 ③熱エネルギーを電気エネルギーに直接変換する熱電変換材料及び廃熱利用技術は欠くことができない重要な基礎技術となると予想される.

2. 研究の目的

これまで、高温で利用可能な熱電材料とし て期待される酸化亜鉛系セラミックスに着 目し、高性能 ZnO 熱電材料の開発、製造技 術の最適化、薄膜熱電材料の開発を行ってき た.高性能 ZnO 熱電材料の開発とその製造 技術の最適化に関しては、有意な研究成果を 得ている.これらの技術を、様々な機器で使 用可能な汎用性の高い技術にする為には、高 電気伝導率、高ゼーベック係数、低熱伝導率 などの特性を維持したままプラズマ成膜技 術を用いて薄膜化する必要がある.

高電気伝導率及び高ゼーベック係数を持 つ薄膜については、液晶ディスプレイなどに 使用される導電性薄膜のプラズマ成膜技術 を利用して生成可能である.それに対して、 低熱伝導率の薄膜形成に対しては、均一な薄 膜では材料内のフォノン熱伝導率が増加す る為、均一な成膜を得意とするプラズマスパ ッタリングなどの通常のプラズマ成膜技術 では実現が困難である.これらの問題を解決 する為には、薄膜内の結晶構造や内部構造を 制御し、サブミクロン~ミクロンオーダーの 粒径を持つ多結晶構造の薄膜を作成するプ ラズマスパッタリング技術を確立する必要 がある.

そこで本研究では,実用的に使用可能な高 性能の酸化亜鉛系熱電材料薄膜の生成を目 的として, プラズマ成膜における薄膜内部の ミクロンオーダーの結晶構造制御技術に着 目し,酸化亜鉛薄膜中の結晶構造を制御する ことによって熱伝導率の制御を行い、高電気 伝導率,高ゼーベック係数,低熱伝導率など の特性を維持した酸化亜鉛系熱電材料の薄 膜化技術の開発を行い、廃熱を熱電変換する 熱電材料と廃熱利用技術の開発を目的とし ている.具体的な目的は、以下の項目である. (1) これまでの研究より、放電プラズマ焼 結(SPS)プロセスによる酸化亜鉛焼結体 内部において,優先的な配向性が観察されて いる. 配向性の発生には、 焼結体内部での電 流や電界が影響を与えている可能性があり, このメカニズムを明らかにすることで、放電 プラズマ焼結プロセスやプラズマ成膜にお ける内部構造制御技術の実現を目指す.

(2)対向形プラズマスパッタリングとプラ ズマ流を併用した新たなプラズマ成膜技術 の開発を行い、サブミクロン~ミクロンオー ダーの結晶状微粒子を含有する薄膜の生成 技術を確立する.プラズマ成膜、プラズマ中 の微粒子制御,放電プラズマ焼結法の各技術 を併用し,実現を目指す.

3. 研究の方法

3-1. 放電プラズマ焼結プロセスにおける 内部構造制御のメカニズム解明

これまでの研究より、放電プラズマ焼結プ ロセスを用いた Zn0 ナノ粒子の焼結体で観 測される特定の結晶軸((002),(102),(103)) の配向性が、SPS プロセスの進展と関係 していることが示されている. 焼結中に試料 に流れる電流および電界がこれらの配向性 に影響を与えている可能性が予想されるこ とから, 試料内部電流と加圧力を制御した状 態でのSPS プロセスを行い、ナノ粒子を 用いた焼結体の内部結晶構造に対する試料 内部電流や加圧力の依存性について実験を 行った.実験では、SPS シンテックス製 放電プラズマ焼結機 SPS -3.20 MK-IV を用い た.(放電プラズマ焼結装置の概略は, Fig.2 からRF電力による誘導加熱装置を除いた ものと同じである.) SPS プロセス中の試 料内部電流と加圧力を制御する為に、アルミ ナ板を試料上下に挿入した焼結容器と, 焼結 試料に加圧力が加わらない様にパンチ長さ を切り詰めた焼結容器で焼結を行い、 微小領 域 XRD による配向性の評価を行った (Fig. 1). 試料内部電流を制御した実験では、内径30 mmのグラファイト製焼結容器に封入した酸 化亜鉛粉末(住友大阪セメント製 Zn0 ナノ粒 子, 平均粒径 20nm) を 573-1273 K の 5 つ の焼結終了温度で焼結し、焼結体の水平断面 (内部電流及び加圧力方向に対する垂直面) における XRD 解析及び SEM を用いた粒成長の 観測を行った.また,加圧力を制御した実験 では対照実験として、SPS プロセスと同 じ加圧力で仮成形した粉末試料を無加圧の 状態で大気炉を用いて焼結し,同様の分析を 行った.

3-2.加熱プロセスと試料内部電流の効果 を独立制御した放電プラズマ焼結プロセス の開発

試料内部電流及び電界の効果を解明して 制御することで、より良好な内部構造制御技 術を開発することが可能になると期待でき る.放電プラズマ焼結プロセスに対する電流、 電界の効果を明らかにするために、内部電流 の効果と加熱プロセスを独立に制御する誘 導加熱を利用した焼結装置の開発を行った (Fig.2).通常のSPS装置では、導電性焼 結容器から生じるジュール加熱によって加 熱が行われる.そこで、高周波コイル (13.56MHz)を用いた誘導加熱を採用するこ とで、加熱プロセスを内部電流の効果と分離 する.真空環境下(p=10-3Pa 程度)で真空 容器内に加圧機構を持つ上下の水冷ラムと 粉末材料(住友大阪セメント製 Zn0 ナノ粒子, 平均粒径 20nm, 質量 9.0g)を封入した外径 40mm, 内径 20mm のカーボングラファイト製 焼結容器を設置し,粉末試料に加圧力を印加 しながら焼結容器を加熱して焼結を行う.加 えて,上下水冷ラム間にパルス電源を接続し, 電流を誘導加熱と独立に焼結容器に印加し, 印加されたパルス電流は焼結試料の電気的 特性に依存して,グラファイトダイと焼結試 料に分かれて流れる.

3-3.対向形プラズマスパッタリングとプ ラズマ流を併用したプラズマ成膜技術の開 発

対向形プラズマスパッタリングと外部プ ラズマ源を併用したプラズマ成膜装置の開 発を行った.本研究では、プラズマスパッタ リングを用いて気相中での材料粒子の成長 を促進し,成長した材料微粒子を基板上に輸 送する為の外部プラズマ源を利用すること で, 基板上に微粒子を内包する微粒子含有型 薄膜の堆積を行うことを目指している.上で 述べた放電プラズマ焼結プロセスの研究結 果より、薄膜中の内部構造が印加される電気 パラメータに依存して変化する可能性があ り, 微粒子を内包するプラズマ成膜に応用す ることにより、 高機能の薄膜の生成が期待で きる. 真空容器内にスパッタリング用ターゲ ット(直径 50mm)2 枚を対向する様に設置し, ターゲット間に RF 電力(*f*=13.56MHz)を印 加することにより、CCP プラズマを生成、タ ーゲット材料をスパッタリングによって気 相中に供給する. ガス圧を高く維持すること によってスパッタされた粒子を気相中で凝 集, 微粒子化し, 電界によって捕捉, 成長さ せる. 捕捉された微粒子は、容器上方から気 流又は設置した ICP プラズマ源からのプラズ マ流によって下方に輸送する. 堆積する薄膜 中に微粒子を含有する様に輸送することで, 微粒子含有薄膜を生成する. なお, 使用する ターゲット ( $\phi$ 50, 厚さ 2~3mm) の製作は 放電プラズマ焼結法を用いて製作した.

4. 研究成果

4-1. 放電プラズマ焼結プロセスにおける 内部構造制御のメカニズム解明

Fig.4に放電プラズマ焼結プロセスにおけ る内部電流制限条件でのXRDピーク強度およ び平均粒径の温度依存性を示す.(100)ピー ク強度で規格化した(002)ピーク強度の温 度依存性によると,内部電流の有無によって 配向性が発生し始める温度に違いがあるも のの,同様に生じている.(Fig.4(a)).また, 焼結試料断面における粒成長の温度依存性 によると,内部電流が存在することによって 試料内の粒成長が抑制されている.粒成長の 開始温度も電流制限条件に比べて100K 程度



Fig.1 内部電流と加圧力を制御した SPS 実験概 略図. (a): 試料内部電流制限, (b): 加圧力制限.



Fig.2 内部電流と加熱プロセスを制御した放電 プラズマ焼結プロセス 概略図



Fig.3 対向形プラズマスパッタリングとプラズマ流 を併用したプラズマ成膜装置 概略図

高い温度から始まっており、1173K 程度にな ると、粒成長が同程度になることが分かった (Fig.4(b)).これらのことから、配向性や 焼結の進展に対する電流の効果が比較的低 温において顕著であり、温度が上昇するに従 って加熱による効果の方が顕著になってい る可能性が示された.

また,加圧力制御,通常SPS,大気炉焼



Fig.4 内部電流を制限した場合の ZnO ナノ粒子
焼結体の配向性及び粒径の温度依存性.(a):
(002)ピーク相対強度,(b):平均粒径



Fig.5 ZnOナノ粒子焼結体内の配向性の焼結
条件依存性. (a):通常の SPS プロセス, (b):
無加圧の SPS プロセス, (c):大気炉焼結, (d):
材料粉末. 焼結温度は(d)を除いて 1273K.

結の XRD ピークの比較では,通常のSPSプ ロセスでは観測されない(002),(102),(103) ピークが無加ESPS,大気炉の順で徐々に 大きくなり(Fig.5 (a)-(c)),大気炉の場合 には原料粉末とほぼ同じく,配向性が観測さ れなかった.大気炉焼結での状態は,加圧力 と内部電流を無くした場合に相当する.この ことから,試料内部電流と加圧力が複合的に 関わることで,酸化亜鉛材料中の配向性が生 じていることが示唆される.

4-2.加熱プロセスと試料内部電流の効果 を独立制御した放電プラズマ焼結プロセス の開発

通常のグラファイト製焼結容器(Fig.1(a) から試料上下のアルミナ板を除いた物)を水 冷ラム間に設置し,誘導加熱コイルに2kWの RF電力を印加して加熱を行ったところ,温度 上昇に伴う放出ガス(p = 1Pa 程度)によっ て焼結容器周辺で放電が発生し(Fig.6(b)), 放出ガスが減少してプラズマが停止した後 も誘導加熱が不安定となり,630K 程度の温度



Fig.6 焼結中に発生する放電現象と温度変化 (a): 焼結前, (b): 焼結中, (c): 温度変化



Fig.7 グラファイトダイ内部を流れる電流の誘導 加熱周波数依存性(φ40のグラファイト円柱を仮 定し,側面(r=20mm)での電流値に対する内部 電流の比率を示す.) 上昇に留まって、不十分な加熱となった.不 十分な加熱の原因としては、表皮効果による 加熱効率の低下が考えられることから、グラ ファイト中に流れる誘導電流量の評価を行 ったところ(Fig.7)、周波数10MHz 程度にな るとグラファイト容器の側面から深さ1mm 程 度の浅い領域のみに誘導電流が流れる条件 となり、十分な誘導加熱が生じていないと考 えられる.

さらに, Fig. 7 の結果を通常のSPSプロセスに適用すると,表皮効果によってグラファイトダイ内部および試料内部の焼結電流がパルス電流の周波数やパルスパターンに依存して変化することを示し,また比較的低い周波数でもグラファイトダイの肉厚の増加に伴って試料内部電流が減衰することを示している.

内部電流の周波数依存性を明らかにする為 に、有限要素法を用いて焼結容器内部の電流 分布を評価した.計算モデルとしては直方体 モデルを用い(Fig.8(a))、焼結容器上下に ド1[V]の交流電源が接続されているとした. 容器の対称形を考慮して全体の8分の1の領 域について計算を行った(Fig.8(b)).また,



Fig.8 有限要素法を用いた焼結容器内部を流 れる電流の電流分布

(a):計算モデル俯瞰図, (b):計算モデル断面図 及び接続回路, (c):周波数 *f* = 360Hz の場合の 電流密度分布, (d): 周波数 *f* = 5kHz の場合の 電流密度分布.

燒結材料 (Fig. 8(b)中, x=15mm 以下, z=5mm 以下) は絶縁体を仮定し(導電率σ=0[S/m]), 焼結容器はグラファイトを仮定してとして いる (導電率σ=10<sup>5</sup> [S/m]). 周波数を一般的 なSPSプロセスと同程度の 360Hz の場合 (Fig.8(c)), 焼結試料周辺でも電流が流れ, 特に焼結試料側面部に電流が集中している が, 5kHz の場合 (Fig. 8(c)), 内部電流が急 激に減衰し, 焼結容器側面部に電流が流れる ことが分かる.また,容器全体に流れる電流 量も大きく減少しており、SPSプロセスが 電源周波数に強く影響を受けることが示唆 される. 効率的な容器の加熱を行い, 加熱プ ロセス及び試料内部電流の焼結に対する影 響を明らかにするために, 100kHz~300kHz 程 度の低周波誘導加熱を利用した放電プラズ マ焼結装置の開発を進める予定である.

4-3.対向形プラズマスパッタリングとプ ラズマ流を併用したプラズマ成膜技術の開 発

Fig. 3 の対向形プラズマスパッタリングと ICP プラズマ流を併用したプラズマ成膜装置 の製作を行った.ターゲット材料は酸化亜鉛 材料を想定し,放電プラズマ焼結装置を用い て焼結条件は加圧力 20MPa,1273K として焼 結を行った(Fig.9(a)).製作した焼結材料 は,XRD 解析より,上述と同様の配向性を持 つ焼結材料であることが分かった.Ar ガス圧 10~40mTorr でターゲット間にRF 電力を印加 し,CCP 放電を生成し(Fig.9(b)),ター ゲット間でのプラズマの電子密度の電力,ガ ス圧依存性を評価し,典型的なガス圧として は,3.0×10<sup>15</sup>m<sup>-3</sup>程度となった.現在のところ,



Fig.9 対向形プラズマスパッタリングによるプラズ マ成膜装置

(a):放電プラズマ焼結プロセスを用いて作成した
 酸化亜鉛ターゲット, (b):ターゲット間に生成した
 CCPプラズマ. (c):電子密度の RF 電力依存性
 (*p* = 40mTorr), (d):電子密度のガス圧依存性(*P* = 50W).

堆積膜としては微粒子を含まない一様な薄 膜がガラス基板上に堆積することが分かっ ている. 今後,ガス圧, RF 電力,フロー量な どの制御を行い,微粒子の発生条件および微 粒子含有薄膜の堆積を進めていく予定であ る.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計3件)全て査読有

- ① <u>T.Misawa</u>, N.Shikatani, Y.Kawakami, T.Enjoji and Y.Ohtsu, "Influence of Internal Pulsed Current on the Sintering Behavior of Pulsed Current Sintering Process", Materials Science Forum, vol. 638-642, pp. 2109-2114, 2010.
- ② N. Shikatani, <u>T. Misawa</u>, Y. Kawakami, M. Ohta, "Microstructure and Thermoelectric Properties of Al-doped ZnO Sintered Body", Materials Science Forum, Vol. 638-642, pp. 2172-2177, 2010.
- ③三沢達也, 鹿谷昇, 川上雄士, 円城寺隆志, 川原正和, 大津康徳, "放電プラズマ焼結 プロセスにおける焼結試料の構造形成に 対する試料内部電流の効果", 粉体および 粉末冶金, 第 56 巻, pp. 744-751, 2009.

〔学会発表〕(計9件)

- <u>T.Misawa</u>, S.Ishibashi, T.Hirai, N.Shikatani, Y.Kawakami, T.Enjoji, M.Kawahara, Y.Ohtsu, "Orientation of ceramics using ZnO nano powder sintered by Spark Plasma Sintering Process", 20th MRS-Japan Academic Symposium, December 20, 2010, Yokohama Port Opening Plaza, Yokohama Media & Communications Center, Hatoba Kaikan, Yokohama.
- ②三沢達也, "パルス通電焼結プロセス中の 電流評価と制御"中部電気利用基礎研究振 興財団開催助成講演会「パルス通電焼結基 礎科学討論会」, 2010年12月11日,か ながわサイエンスパーク KSP 西棟7階711 号室.
- ③三沢達也,石橋奏太朗,平井智紀,鹿谷昇,川上雄士,円城寺隆志,川原正和,大津康徳, "内部電流と加熱プロセスを制御した放電プラズマ焼結プロセスの開発",粉体粉末冶金協会平成22年度秋季大会,2010年11月11日,京都大学百周年時計台記念館.
- ④三沢達也,石橋奏太朗,鹿谷昇,平井智紀,川上雄士,円城寺隆志,川上正和,大津康徳, "放電プラズマ焼結プロセスを利用した酸化亜鉛ナノ粒子焼結体の特性",第71回応用物理学会学術講演会(秋季大会),2010年9月17日,長崎大学.
- ⑤<u>三沢達也</u>, 鹿谷昇, 川上雄士, 円城寺隆志, 川原正和, 大津康徳, "放電プラズマ焼結

プロセスを用いた Zn0 焼結体の配向性に対 する内部電流と加圧力の影響",粉体粉末 冶金協会平成 22 年度春季大会,2010 年 5 月 26 日,早稲田大学国際会議場.

- (6) <u>T.Misawa</u>, N.Shikatani, Y.Kawakami, T.Enjoji, Y.Ohtsu, "Characteristics of Al-doped ZnO thermoelectric materials using Spark Plasma Sintering Process", 27th Symposium of Plasma Processing, February 1-3, 2010, Yokohama Port Opening Plaza, Yokohama.
- ⑦ <u>T.Misawa</u>, N.Shikatani, Y.Kawakami, T.Enjoji and Y.Ohtsu, "Generation of Al-doped Thermoelectric Materials using Spark Plasma Sintering Method", Seventh Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2009), September 23, 2009, Bexco Conference Center, Korea.
- (8) <u>T.Misawa</u>, N.Shikatani, Y.Kawakami, T.Enjoji and Y.Ohtsu, "Influence of Internal Pulsed Current on the Sintering Behavior of Pulsed Current Sintering Process", International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials (Thermec' 2009), August 27, 2009, Maritim Hotel, Berlin, Germany (Invited talk).
- ⑨三沢達也, 鹿谷昇, 川上雄士, 円城寺隆志, 川原正和, 大津康徳, "放電プラズマ焼結 プロセスにおける焼結試料の構造形成に 対する試料内部電流の効果", 粉体粉末冶 金協会平成21年度春季大会, 2009年6月 3日, 京都工芸繊維大学(招待講演).

〔図書〕(計1件)

①<u>三沢達也</u>(分担執筆), "パルス通電場プロ セッシング総説集(関西パルス通電懇話会編 集委員会編)", 2010年6月20日第1版第 1 刷発行,編集:関西パルス通電懇話会編集 委員会(編集代表者 巻野勇喜雄),関西パル ス通電懇話会,株式会社ティー・アイ・シー, pp. 50-59.

〔産業財産権〕 〇出願状況(計0件)

○取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織
(1)研究代表者
三沢 達也 (MISAWA TATSUYA)
佐賀大学大学院工学系研究科・助教
研究者番号: 70346873